

Установлено, что при одних и тех же режимах формирования барьера ионная очистка увеличивает высоту барьера, что определяет такие важные свойства диодов Шоттки, как малые токи утечки, временная стабильность, высокие пробивные напряжения, помехозащищённость, что важно при производстве изделий для автомобильной электроники.

Список цитируемых источников

1. Особенности формирования границы раздела Si/PtSi в диодах Шоттки для силовой электроники / А.С. Турцевич [и др.] // Доклады БГУИР. 2003. № 4 (16). С. 53—58 ; Формирование барьеров Шоттки на основе силицидного никель-платинового сплава / А.С. Турцевич [и др.] // Материалы и структуры современной электроники : сб. тр. 5-й Междунар. науч. конф. (10—11 окт. 2012 г.). Минск, 2012, С. 88—91.
2. The influence of Pt redistribution on Ni_{1-x}Pt_xSi growth properties / J. Demeulemeester [et al.] // J. Appl. Phys. 2010. Vol. 108. P. 043505.1—043505.11 ; Effects of additive elements on the phase formation and morphological stability of nickel monosilicide films / C. Lavoie [et al.] // Microelectronic Engineering. 2006. Vol. 83. P. 2042—2054.
3. Технология интегральной электроники / Л.П. Ануфриев [и др.] / под общ. ред. А.П. Демченко и Л.И. Гурского. Минск : Интегралполиграф, 2009. 379 с.

Поступила в редакцию 20.05.2016.